	2.光净总结 考·选办一等四章 选办二等四章 选办三第四章]
	基本的式 (课内)
	RII Y
	2. 均理光学 dž=nl, dax=ll, lv=C, T=2IIVLC。
	3. 光向本质 モ=hv, Ekm==meve= elle, Ekm=hv-Wo, p= 先, 大=Roo(立元). hv=En-Em
<u> </u>	四何光学概念
	1. 折射定律: 三张共间,两张分店,正弦定比,(光路可递)。
	2. (绝对)折射率:光从真圣(空气)射入某种介质发生折射时,入射角正弦与折射前正弦之比。
	头光落介质:折射车较大的介质 ("光搅得"篇")。
	4. 光疏介质:折射率较小的介质("知"说得"说)。
	5.全反射: 光落介质射向光流介质, 折射光完全消失, 只剩下反射光的现象。
	6.临界南:全反射折射角呈时的入射角。
Ξ.	当有两束光 以 7 以2时 (对光液)来流)
	1. 液动描述: 儿·<儿(真层或介质), C1 <c2(介质,真层g=c2), t1<t2,="" w1="">W2, K1>k2。</c2(介质,真层g=c2),>
	2.1/1何光学: m>n2, Oci< Oc2, 折射偏折更大,更易发生全反射,折射光效率先消失。
	3.光液性质:干涉衍射系领偏难,更难衍射,准直性更好。
	4.电磁液谱: LICI < L2C2,作为载液(病点被离了), \$B 查青绿黄橙红。
	5.光才胜质: E, > E, , P, > P2, Erm; > Erm; > Lo; > Lo; > Lo, 更易产生光电子。
囡.	光旬干涉
	1. 理论:相位差(2k)下/光程程(n)从,相长;相位是(2k+1)下/光耀系(n+之)从,相消。
	2. 双缝干涉: 单缝确保相干性, 缝窄缝间距界系纹窄, 屏距宽, dax=11~记查量级。
	3.落膜干涉:看落膜/薄与隙上下表面间距,牛顿环暗斑,肥皂膜重力下厚上著,地形圆口诀。
	"高改(向厚处的)谷(薄),低的(向落处的)脊厚),缓坡稀,陡坡器"。
	4. 半波提·仅当在光流介质中传播的光在光落介质表面反射时出现相位茂度至。Lit论正入射
	万增透膜、反射光干涉相消(能量守恒),两束光均半液损,厚华。
1	6. 增反膜: 反射光干涉相长,一束光丰液振,厚华。
Į,	长细行射
ν.	1. 巴比涅原理: 缝写障碍物大小的状相同时, 衍射系统互补。
	2. 缝越冷, 光光酸弱, 条纹磁宽。 (对树同缝, 液长越长, 条纹越宽)
	3. 光栅: 精确度、分转率高,刻痕处漫反射, 同透光透射光栅、金属反射光栅。
	4. 泊机壳斑:支持液动说。

六、光的偏振				
1. 宽义: 证明光是模	液。			
		的电磁波通过(即与速	振而不重,体现	徇异性.
		太阳光河认为是不偏		
L. 电磁波的产生 (2)				
		趣场,不均习受化的磁		满凝电场。
2. 涡旋磁场: 废他	场产生正方向涡旅	疏场,不均匀变化的电	为可产生正方的的变化	满族流动。
		为, 受化的电动产生变化		
4. 收射系件: 振菊				
八.无残电波"五调"			一种调】	
		号,前者即载被"载波"		凋敬,恐怕两种。
	城平随信号改变。			
	振幅随信号改度。			jeij gerbac
4.调谐使接收电		eks nijirka e obij		
	亚原出来,和调制的	通过程。		
也. 些辐射(绝对黑体	•			
_		成液(与吸收本级成正比), 带屋腔的小孔即为	绝对黑体。
		甘强度做大,峰值液+	그런 그렇게 하는데 되었다.	6, g = 2, g = 188
•		金斯公式与维恩公式、编码		ま 不 ろ l 人 を - h レ i 社 引
十. 电磁波谱			E. Japanese Mener	
	A.导航,LC振荡产	生,波长期(104 m~	10m).	
		mn2x10m) 中矩夜(2	Xiom~5xiom) 短波((AM) Fommiom)
地渡 (多次反集		4	天	反射-次 夜(电场压低通流液)
微液:硫羟	美(8个小LC振勒)产	生,准直性好,波长巷		- 1: 1
		测FM);应用:电视.雷达		120共振).射电。
		摄影、测温,分子能级/		
		360nm)~31+67.2×10-7		
		满海, 促Ca吸收, 16身		
	20	箱内,内层好跃迁/新		
		如有能级跃迁,110 ¹¹ m。		
1	,	, ,		

1.全反射:全反射核脱、光导纤维(内窥脱、光纤通信)。 2.薄膜干涉:增速膜、增反膜、平屑度检测。 3. 衍射:衍射光栅(透射/反射)、外射残晶体衍射。 4.偏振:偏振滤光片,激光(介相同,分恒定,振动方向相同)。 十二.微光优势 1. 理朝光源:科研如干涉家施。 2. 传递信息:可被调料,结合光导纤维。 3. 平行度好:传播-定距高仍有一定强度,精确测距.指向设备。 4. 亮度很高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 科研工具:光清互物质垢构,分子运动和反应形程,对时间起高精度测量。 十三.光电效应 1. 戏家:截止频率, 诡和电流(仅写光子数成正相关), 遏止电压(与频率正相关)、瞬时性。 2. 经实验程:不应有在截止频率, 遏止电压运光强有关, 羽光不应有瞬时性。	† -	. 光学应用
2. 蒋膜干涉:增盛膜、增坂膜、平屑度检测。 3. 衍射:衍射光栅(透射/反射)、×射线晶体衍射。 4. 偏振: 偏振: 偏振: 光片,激光(月相同,今阳足,振动市何相同)。 十二. 徽光优势 1. 理相光振: 料研如干涉采旋。 2. 传递信息: 可被调料, 苦合光多折难。 3. 平行度好:传播- 定距高仍有一定强度,精确测距, 括何设备。 4. 亮度很高:超时集中大能量,切割、焊接。 5. 料研工具:光清互物质施构, 分引运动和反应历程, 对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 政察: 截止城岸, 陷和电流(仅每光子数成正相采), 遏止电压(与城岸正相采)、瞬时,性。 2. 经更轻难: 不应标在截止城率, 遏止电压定至光强有采, 羽光不应有瞬时性。 3. 聚因斯坦解释: hu>>Wo才能逼出, 压抗仅与少有关, 电子一次性吸收光注射能量, 光分散膜流纤维,以上一口圆露: 斜率色, 纵截距一些, 横截距坐。 4. Uc-以圆塞: 斜率色, 纵截距一些, 横截距坐。 4. Uc-以圆塞: 斜率色, 纵截距一些, 横截距坐。 4. 加少上记, 设的光子无流吸收(过作佛为正, 容储量低, 大块物质特合出汗及条规级。 3. hu>-E, 电引被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跌近, 规律同上。		
 5. 衍射: 衍射光栅(透射/反射)、×射戏晶体衍射。 4. 侗族: 偏振病光片,激光(月相同,49恒定,振动市何相同)。 十二. 漁光优势。 1. 理相光振: 料研如干涉采旋。 2. 传递信息: 河被调料, 杂合光音纤维。 3. 平行度好: 传播- 冷距高仍有一冷强度,精确测距. 指何设备。 4. 麂度银高: 短时集中大能量,切割、焊接。 5. 料研工具: 光清百物仮始期,分引运动和反应历程,对时间起高精度测量。 十三. 光电效应。 1. 政家:截止城库, 沿和电流(仅9光子数成正相关), 遏止电压(与城库正相关), 瞬时性。 2. 经奥辐准: 不应标在截止城库, 遏止电压(号、积未下应有瞬时性。 3. 展风斯坦解释: hu>>Wo才能遮出, 压响仅与少有关,电子一次性吸收光注射能量,光升截决镜系生口。 现本电子队迁积项。 1. 电子可吸收 hu≈ Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei-Ej的光子无流吸收(dE能带 ≈ E, 容错量低, 大块物质耦合由许多条级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跃迁, 规律同上。 		
4.偏振·偏振流光片,激光(f相同, Δφ恒定,振动下向相同)。 十二. 癥光忧势 1. 理相光源:科研如干涉实验。 2. 传递信息:可被调料,转合光导纤维。 3. 平行度好:传播-定距高仍有一定强度,精确测距.指向设备。 4. 壳度根高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 料研工具:光清与物质端期,分引运动和反应历程,对时间超高精度和量。 十三. 光电效应 1. 稅家:截止飯率,泡和电流(农与光子教成正相关),遏止电压(与飯率正相关)、瞬时性。 2. 经奥辐准:不应届在截止饭车,遏止电压应与光强有关,别光不应有瞬时性。 3. 爱风斯坦解释:hu>>Wo才能逼出,压耐仅与口有关,电子一次性吸收光才全部能量,光习数决论系4. Uc-以圆家:斜率告,纵截距一些,横截距上。 十四. 稂不电引跃迁规从] 1. 电子可吸收加α 云:与的光习发生跃迁。 2. hu ≠ 云:写的光习无在吸收(d 正能带 积 € , S 销量低、大块物质耦合血许多能级)。 3. hu> - E,电引被电离。 4. 为个光习可以一次性导致跃迁,规律同上。		
十二. 瀛光忧勢 1. 理朝光源:科研如于涉实施。 2. 传递信息: 可被调料, 转合光身纤维。 3. 平行度好: 传播-冷距高仍有一冷强度, 精确测距,指何设备。 4. 壳度强高: 短时军中大能量, 切割、焊接。 5. 科研工具: 光清互物质菇胸, 分子运动和反应历程, 对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 祝家:截止频率, 泡和电流,仅分光子数成正相关), 遏止电压(与频率正相关), 瞬时性。 2. 经奥辐准: 不应标在截止频率, 遏止电压与光强有关, 羽光不应有瞬时性。 3. 展闲斯坦解释: hu>>w才能通出, 压耐(至)力有关, 电子一次性吸收光子全部能量, 光子最实现系统, 生儿c-以圆家: 斜率色, 纵截距一些, 横截距 號。 4. Ⅱc-以圆家: 斜率色, 纵截距一些, 横截距 號。 4. Ⅱc-以圆家: 斜率色, 纵截距一些, 横横距 號。 1. 电子可吸收 hu ≈ Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. hu ≠ Ei-Ej的光子无法吸收 (dE能带 ≈ E, 容错量低, 大块物质糖合出许多能级)。 3. hu> - E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跃迁, 规律同上。		
2. 传递信息:可被调料,转合光导扩推。 3. 平行度好:传播-定距高仍有-定强度,精确测距,指向设备。 4. 底度很高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 料研工具:光清互物质据构,分子运动和反应历程,对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 故家:截止懒弃,泡和电流(仅至光子数成正相关),遏止电压(与懒弃正相关),瞬时性。 2. 经奥较难: 不应后在截止懒弃,遏止电压运车光强有关, 羽光不应有瞬时性。 3. 褒闲惭袒解释: hw>Wo才能追出,压减至少有关,电子一次性吸收光注部能量,光子数块饱和4. Uc-以图象:斜率色,纵截距一管,横截距壁。 十四. 稜承电子跃迁规则 1. 电子可吸收 hu≈ Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei-Ej的光子无疾吸收(dE能带≈ E, 容错量低,大块物质耦合出许多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。	† <i>-</i>	
3. 平行度好:传播-定距高仍有一定强度,精确测距.括何设备。 4. 亮度很高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 科研工具:光谱与物质结构,分子运动和反应历程,对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 双家:截止频率, 泡和电流(农与光子数成正相关), 過止电压(与频率正相关), 瞬时性。 2. 经典额难: 不应存在截止频率, 遏止电压运与光强有关, 羽光不应有瞬时性。 3. 最同斯坦解释: hu>>Wo才能虚出, Exin仅与以有关, 电子一次性吸收光子全部能量, 光子数次饱和4. Uc-以圆家: 斜率告, 纵截距一管, 横截距 號。 4. Uc-以圆家: 斜率告, 纵截距一管, 横截距 號。 1. 电子可吸收 hu≈ Ei- Ej 的光子发生跃迁。 2. hu≯ Ei- Ej 的光子无法吸收(dE能带水E, 容睹量低, 大块物质糖合出汗多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跌近, 规律同上。		1. 理想光澈:科研如干涉实施。
4. 麂度很高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 科研工具:光清互物质据构,分子运动和反应历程,对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 积豫:截止频率, 饱和电流(仅可光子数成正相关), 遏止电压(与颜率正相关), 瞬时性。 2. 经典额难: 不应有在截止频率, 遏止电压应可光强有关, 羽光不应有瞬时性。 3. 最闲斯坦解释: hu>Wu才能遍出, Epin仅与U有关, 电子一次性吸收光注部能量, 光子数次饱和4. Uc- 以图象: 斜率色, 纵截距一些, 横截距坐。 十四. 稂不电子跌近规则 1. 电子可吸收 hu≈ Ei- Ej 的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei- Ej 的光子无在吸收 (dE能带 池E, 容储量低, 大块物质耦合出许多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跌近, 规律同上。		2. 传递信息: 可被调料, 结合光导折维。
4. 麂度很高:短时集中大能量,切割、焊接。 5. 科研工具:光清互物质据构,分子运动和反应历程,对时间起高精度测量。 十三. 光电效应 1. 积豫:截止频率, 饱和电流(仅可光子数成正相关), 遏止电压(与颜率正相关), 瞬时性。 2. 经典额难: 不应有在截止频率, 遏止电压应可光强有关, 羽光不应有瞬时性。 3. 最闲斯坦解释: hu>Wu才能遍出, Epin仅与U有关, 电子一次性吸收光注部能量, 光子数次饱和4. Uc- 以图象: 斜率色, 纵截距一些, 横截距坐。 十四. 稂不电子跌近规则 1. 电子可吸收 hu≈ Ei- Ej 的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei- Ej 的光子无在吸收 (dE能带 池E, 容储量低, 大块物质耦合出许多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跌近, 规律同上。		3. 平行度好: 传播-冷距高仍有-冷强度, 耩确测距. 指向设备。
十三. 光电效应 1. 稅家:截止飯率. 饱和电流(仅每光子数成正相关),遏止电压(每飯率正相关),瞬时性。 2. 经典额难: 不应有在截止飯率,遏止电压应与光强有关,羽先不应有瞬时性。 3. 覆阁斯坦解释: hu>Wo才能遍出, 与mi仅与以有关,电子一次性吸收光子全部能量,光子数决饱和 4. Uc-以图家: 斜率色, 纵截距一些,横截距光。 十回. 稜承电子跃迁规从] 1. 电子可吸收 hu≈ Ei-Ej 的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei-Ej 的光子无杰吸收(dE能带 ≈ E, 容储量低, 大块物质耦合出汗多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跌迁,规律同上。		•
1. 稅家:截止飯车, 饱和电流(仅至光子数成正相采), 過止电压(豆飯率正相采), 瞬时性。 2. 弪與鬆难: 不应标在截止飯车, 遏止电压应至光振有采, 弱光不应有瞬时性。 3. 褒因斯坦解释: hル>Wo才能逼出, Emi仅匀以有采,电子一次性吸收光子全部能量, 光子数决饱和 4. Uc- 以图象: 斜车告, 纵截距一些, 横截距 光。 十四. 稜不电子跃迁积从] 1. 电子可吸收 hu≈ Ei- Ej的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei- Ej 的光子无法吸收 (dE能带≈ E, 容错量低, 大块物质耦合出汗系能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跌迁, 规律同上。		5.科研工具:光清与物质结构,分子运动和反应历程,对时间起高精度测量。
2. 经典额难: 不应标在截止做率,溢止电压与光强有关,羽光不应有瞬时性。 3. 爱冈斯坦解释: hu>wò才能遍出, fimi仅与v有关,电子-次性吸收光子全部能量,光子数决论和4. Uc-以图象: 斜率色,纵截距一些,横拟距光。 十四. 被承电子跃迁规则 1. 电子可吸收 hu≈ Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. hu≠ Ei-Ej的光子发生跃迁。 3. hu>-E,电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。	1:	三. 光电效应
3.最闲斯坦解释:hu>>Wo才能遍出,Frin仅与v有关,电子-次性吸收光注部能量,光对数块设施 4. Uc- U图象: 斜车色, 纵截距一些, 横截距光。 十四. 被不电子跃迁规从了 1. 电子可吸收hu≈Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. hu≠Ei-Ej的光子无杰吸收(dE能带≈E, Se销量低, 大块物质耦合出汗及能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 为个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。		1. 战家:截止城车,论和电流(仅至光子教成正相关),遏止电压(与城平正相关),瞬时性。
4. Uc- U图象: 斜率色, 纵截距一卷, 横截距光。 十四. 被乐电子跃迁规则 1. 电子可吸收加≈Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. 加≠Ei-Ej的光子无杰吸收(dE能带水E, 容睹量低, 大块物质耦合出汗系能级)。 3. 加>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跃迁, 规律同上。		2. 经典额难: 不应标在截止频率, 温止眶症与光强有关, 殉光不应有瞬时性。
十四. 被不电子跌近规则 1.电子可吸收加≈Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. 加≠Ei-Ej的光子无杰吸收(dE能带虫E, Se Hu = G, 大块物质耦合出汗及能级)。 3. 加>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。		3. 爱冈斯坦解释:hu>Wo才能遍出,Emi仅与V有关,电子一次性吸收光注部能量,光子数块饱和
1.电子可吸收加≈Ei-Ej的光子发生跃迁。 2. 加≠Ei-Ej的光子无杰吸收(dE能带虫E, 容睹量低, 大块物质耦合出汗及能级)。 3. 加>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。		4. Uc-21图象:斜率色,纵截距一卷,横截距光。
2. hu + Fi-Fj 的光子无杰吸收(dE能带 &E, 容睹量低, 大块物质耦合出许多能级)。 3. hu>-E, 电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。	十四	. 我不电子改迁规则
3. hu>-E,电子被电离。 4. 多个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。		1.电子可吸收加≈Ei-Ej的光子发生跃迁。
4. 多个光子可以一次性导致跃迁,规律同上。		2. hu≠bi-bj的光子无法吸收(dE能带电E,容错量低,大块物质耦合出许多能级)。
5. 电子等碰撞可造成跃迁,且为余的最少能量作为残留动能。		· ·
		5.电子等碰撞可造成跃迁,且多余的最少能量作为致留动能。